

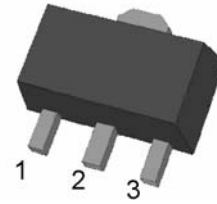
Epitaxial Silicon Transistor(PNP) 三極管

FHB1273

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

Audio power amplifier applications
 Complement to FHD3205

SOT-89



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

| PIN NAME 管腳符號 | PIN NUMBER 引腳序號 | FUNCTION 功能 |
|------------------|-----------------|----------------|
| | SOT-89 | |
| B | 1 | BASE |
| C | 2 | COLLECTOR |
| E | 3 | EMITTER |

MAXIMUM RATINGS(T_a=25°C) 最大額定值

| CHARACTERISTIC 特性參數 | Symbol 符號 | Rating 額定值 | Unit 單位 |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------|
| Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓 | V _{CEO} | -30 | Vdc |
| Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓 | V _{CBO} | -30 | Vdc |
| Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓 | V _{EBO} | -5 | Vdc |
| Collector Current 集電極電流 | I _C | -2 | Adc |

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

| CHARACTERISTIC 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|--|------------------------------------|-------------------|---------|
| Collector Power Dissipation 集電極耗散功率 | P _c | 1 | W |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度 | T _J T _{stg} | 150 , -55 ~150 | °C |

DEVICE MARKING 打標

FHB1273Q=3Q(100~200),FHB1273P=3P(160~320)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Test Condition 測試條件 | Min 最小值 | Type 典型值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|--|----------------------|--|---------|----------|---------|---------|
| Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓 | V _{(BR)CEO} | I _C =-10mA, | -30 | — | — | V |
| Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓 | V _{(BR)CBO} | I _C =-100μA | -30 | — | — | V |
| Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓 | V _{(BR)EBO} | I _E =-1.0mA | -5.0 | — | — | V |
| Collector Cutoff Current 集電極截止電流 | I _{CBO} | V _{CB} =-30V, I _E =0 | — | — | -100 | nA |
| Emitter Cutoff Current 發射極截止電流 | I _{EBO} | V _{EB} =-5V, I _C =0 | — | — | -100 | nA |
| DC Current Gain 直流電流增益 | h _{FE} | V _{CE} =-2V, I _C =-500mA | 100 | — | 320 | — |
| Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 | V _{CE(sat)} | I _C =-1.5A, I _B =-30mA | — | — | -600 | mV |
| Base-Emitter Voltage 發射極-基極電壓 | V _{BE} | V _{CE} =2V, I _E =500mA, | — | — | -950 | mV |
| Transition Frequency 特徵頻率 | f _T | V _{CE} =-2V, I _E =-500mA, | — | 120 | — | MHz |
| Collect Output Capacitance 輸出電容 | C _{Ob} | V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz | — | 48 | — | pF |